

Silicon Diode

BAY135

125V / 200mA

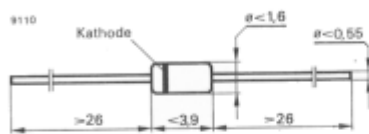
DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BAY 135**Silizium-Planar-Diode****Anwendungen:** Schutzschaltungen, Verzögerungsschaltungen**Besondere Merkmale:**

- Sehr niedriger Sperrstrom

Abmessungen in mm

Standard Glasgehäuse
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,15 g

Bestempfung: Klartext**Absolute Grenzwerte**

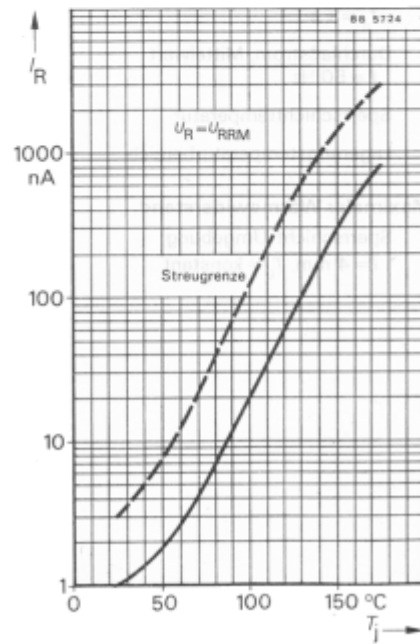
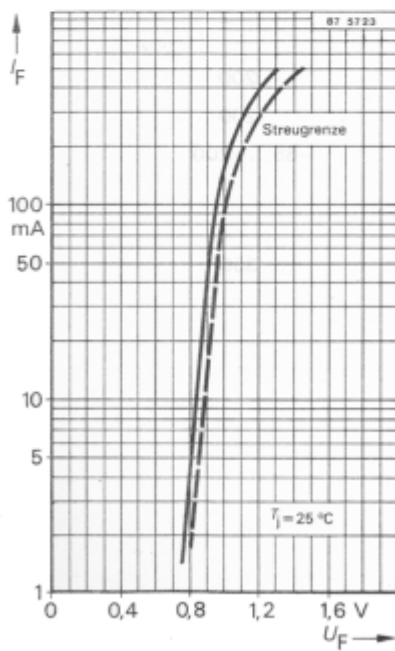
Stoßsperrspannung	U_{RSM}	140	V
Periodische Spitzensperrspannung	U_{RRM}	140	V
Sperrspannung	U_R	125	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 1 \text{ s}$	I_{FSM}	2	A
Durchlaßstrom, Mittelwert $f = 50 \text{ Hz}$	I_{FAV}	200	mA
Sperrschichttemperatur	T_j	200	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	-65 ... +200	°C

Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung $l = 4 \text{ mm}, T_L = \text{konstant}$	R_{thJA}	350	K/W
--	------------	-----	-----

BAY 135

Kenngrößen		Min.	Typ.	Max.
$T_J = 25\text{ °C}$, falls nicht anders angegeben				
Durchlaßspannung $I_F = 100\text{ mA}$	U_F			1 V
Sperrstrom $E^1) \leq 500\text{ lx}$, U_R $U_R, T_J = 125\text{ °C}$ $U_R = 60\text{ V}$	I_R			3 nA
	I_R			0,5 μA
	I_R			1 nA
Durchbruchspannung $I_R = 5\text{ }\mu\text{A}$	$U_{(BR)}^{2)}$	140		V
Diodenkapazität $U_R = 0$, $f = 1\text{ MHz}$	C_D			3 pF



¹⁾ Beleuchtungsstärke; ²⁾ $\frac{t_p}{T} = 0,01$, $t_p = 0,3\text{ ms}$